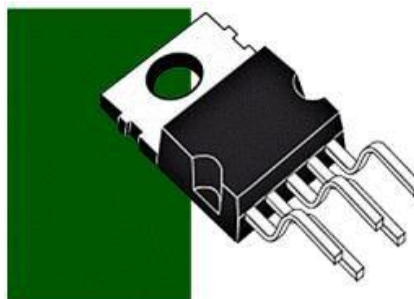




[RE-9] СХЕМОТЕХНІКА



Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	<i>Перший (бакалаврський)</i>
Галузь знань	<i>17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації</i>
Спеціальність	<i>172 Електронні комунікації та радіотехніка</i>
Освітня програма	<i>Радіотехнічні комп'ютеризовані системи Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія Технології радіоелектронної боротьби</i>
Статус дисципліни	<i>Нормативна</i>
Форма навчання	<i>очна</i>
Рік підготовки, семестр	<i>2 курс, осінній та весняний семестри</i>
Обсяг дисципліни	<i>7 кредитів (Лекц. 72 год, Практик. 36 год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год)</i>
Семестровий контроль/ контрольні заходи	<i>Екзамен</i>
Розклад занять	<i>https://rozklad.kpi.ua</i>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Інформація про керівника курсу / викладачів	<i>Лектор: к.т.н., ст.. викл. ТОВКАЧ Ігор Олександрович, e-mail – tovkach.igor@gmail.com к.т.н., проф. Мовчанюк Андрій Валерійович, тел. 0677443441 e-mail – movchanuk@rtf.kpi.ua Лабораторні: к.т.н., доцент, с.н.с., ПІДДУБНИЙ Володимир Олександрович, тел. 0671929139, e-mail - VAPoddubny@gmail.com к.т.н., доц., ЛАЩЕВСЬКА Натаія Олександрівна, e-mail – ivanyuk@ros.kpi.ua</i>
Розміщення курсу	<i>Посилання на дистанційний ресурс: Moodle http://iot.kpi.ua/lms/course/view.php?id=28 https://do.ipu.kpi.ua/course/view.php?id=6394 https://do.ipu.kpi.ua/course/view.php?id=6417</i>

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Метою кредитного модуля є:

- набуття знань про сучасну компонентну базу РЕА; будову і принцип дії, характеристики та параметри електронних приладів та інтегральних мікросхем (IC), основні напрямки їх розвитку;
- набуття знань про вплив конструкцій та властивостей матеріалів на характеристики компонентів, а також про вплив технологічного розкиду та умов експлуатації на основні параметри компонентів РЕА, електронних приладів та IC;
- навчитися застосовувати набуті знання для правильного вибору схмотехнічних рішень при розробці РЕА;
- набуття навичок вимірювання параметрів, електронних компонентів, об'єктивної оцінки функціональних та параметричних можливостей компонентної бази РЕА
- Аналізувати схмотехнічні рішення окремих каскадів підсилення та підсилювальних пристроїв різного призначення;
- Розробляти технічні завдання на проектування електронних пристроїв;
- Розробляти структурні та принципові схеми підсилювальних пристроїв різного призначення;
- Проектувати каскади підсилення та підсилювальні пристрої різного призначення;
- Визначати та вимірювати основні параметри та характеристики підсилювальних пристроїв. Предметом кредитного модуля є:
- пасивна компонентна бази радіоелектронної техніки, до якої відносяться резистори, конденсатори, котушки індуктивності;
- активна компонентна бази радіоелектронної техніки, до якої відносяться діоди, тиристори, біполярні та польові транзистори, електронні лампи, трубки та інше, гібридні та інтегральні мікросхеми.
- Принципи схмотехнічної побудови та розрахунку підсилювальних каскадів та підсилювачів різного призначення, та пристроїв аналогової обробки сигналів. В дисципліні розглядається їх схмотехніка, технологія виготовлення та особливості використання в сучасних радіотехнічних системах, їх характеристики та властивості.

Згідно з освітньо-професійною програмою дисципліна забезпечує

Загальні компетенції (ЗК):

- Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях (ЗК 02).
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК 04).
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 07).
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблем (ЗК 08).

Фахові компетентності (ФК):

- Здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ФК 04).
- Здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, досліду перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ФК 10).
- Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ФК 15).

Програмовані результати навчання (ПРН):

- Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв'язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (ПРН 01).
- Застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв'язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (ПРН 02).

- Пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов'язувати їх з відповідною теорією (ПРН 04).
- Адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПРН 06).
- Застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (ПРН 14).
- Розуміння та дотримання вітчизняних і міжнародних нормативних документів з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем (ПРН 17).

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна базується на знаннях з дисциплін «Основи теорії кіл», «Інженерна та комп'ютерна графіка» та є основою для вивчення дисципліни «Дизайн елементів інтелектуальних радіоелектронних систем».

3. Зміст навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Схемотехніка» складається з двох розділів: розділ 1 «Електронні компоненти» та розділ 2 «Аналогова схемотехніка». Розділ 1 «Електронні компоненти» викладається в третьому семестрі а розділ 2 «Аналогова схемотехніка» - в четвертому семестрі.

Зміст розділу 1 «Електронні компоненти»

Тема 1. Загальна характеристика компонентної бази РЕЗ

Компонентна база РЕЗ. Загальна характеристика компонентної бази. Загальні відомості про пасивні та активні радіоелементи. Класифікація РЕЗ за компонентною базою та конструкцією.

Тема 2. Пасивні радіокомпоненти.

Тема 2.1. Діелектричні матеріали. Класифікація та призначення діелектричних матеріалів. Пасивні та активні діелектрики. Діелектрики, які використовуються в РЕЗ. Діелектричні матеріали для друкованих плат (фольговані гетинакс, склотекстоліт, поліетилен та фторопласт), гібридних інтегральних мікросхем та НЧ та НВЧ діапазонів (ситали, сапфір, двоокис кремнію, нітрид кремнію то що). Конструктивних елементів (радіотехнічна кераміка).

Тема 2.2. Конденсатори. Призначення конденсаторів. Класифікація. Основні характеристики та параметри. Ряди номінальних значень ємності та ряди допусків. Високочастотні та низькочастотні конденсатори. Еквівалентні схеми. Конструкція конденсаторів постійної та змінної ємності. Конденсатори для поверхневого монтажу. Конденсатори з електричним управлінням ємністю: варистори та варікапи. Конденсатори ГС та напівпровідникових інтегральних мікросхем (НП ІС).

Тема 2.3. Провідникові матеріали. Основні властивості та класифікація. Матеріали високої провідності для навісного монтажу, друкованих плат та ІС. Обмоточні та радіомонтажні дроти. Матеріали високого питомого опору та їх використання для створення резисторів. Тонкоплівкові резистивні матеріали для ІС.

Тема 2.4. Резистори. Класифікація. Основні характеристики та еквівалентні схеми. Ряди номінальних значень опору та ряди допусків. Конструктивні типи резисторів різного призначення (для навісного та друкованого монтажу, надвисокочастотні та ін.), резистори для ГС та НП ІС.

Тема 2.5. Магнітні матеріали. Характеристики магнітних матеріалів. Магнітом'які та магнітотверді матеріали. Трансформаторне залізо. Феро- та феримагнетики. Ферити та магнітодіелектрики. Магнітні плівки.

Тема 2.6. Котушки індуктивності. Основні властивості котушок індуктивності. Класифікація. Характеристики котушок індуктивності. Високочастотні котушки індуктивності та ВЧ дроселі. Їх призначення та конструкції. Розрахунок індуктивності та числа витків. Варіометри. Друковані котушки індуктивності. Котушки індуктивності для ПС. Характеристики та параметри дроселів та трансформаторів. Конструкції НЧ та ВЧ дроселів та трансформаторів. Особливості роботи на підвищених (високих) частотах.

Тема 2.7. Контактні та комутаційні пристрої. Перемикачі. Реле. З'єднувачі. Контактні та комутаційні пристрої мікросбірок та мікроблоків.

Тема 2.8. Друковані плати. Класифікація. Матеріали друкованих плат. Конструкція друкованих плат. Особливості друкованих плат НВЧ діапазону. Односторонні, двосторонні та багатошарові друковані плати. SMD – компоненти та технологія.

Тема 3. Напівпровідникові матеріали.

Тема 3.1. Фізичні основи напівпровідників. Основні матеріали напівпровідникової техніки. Основи зонної теорії напівпровідників. Вільні носії зарядів у власних та домішкових напівпровідниках. Основні та неосновні носії зарядів. Генерація та рекомбінація рухомих носіїв зарядів. Рівноважний та нерівноважний стани напівпровідника.

Тема 3.2. Концентрація носіїв заряду. Концентрація носіїв заряду та рівень Фермі у власному та домішковому напівпровідниках. Залежність рівня Фермі від температури та концентрації домішок.

Тема 3.3. Струми в напівпровіднику. Дрейфовий струм: дрейфовий рух носіїв заряду, рухливість носіїв заряду. Залежність рухливості від температури, концентрації домішок, напруженості електричного поля. Дифузійний струм: дифузійний рух часток, коефіцієнт дифузії, дифузійна довжина. Рівняння дифузії. Електропровідність напівпровідників. Поверхневі явища: поверхневі стани, поверхневий заряд, поверхнева рекомбінація.

Тема 4. Напівпровідникові діодні структури.

Тема 4.1. Електричні переходи. Різновиди електричних переходів. Контактна різниця потенціалів. Електронно-дірковий перехід в рівноважному (потенціальний бар'єр, потенціальна діаграма, ширина переходу) та нерівноважному стані (інжекція, екстракція).

Тема 4.2. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) ідеалізованого переходу. ВАХ реального переходу (струми генерації рекомбінації, опір бази, пробої переходу, ємності переходу). Контакт метала-напівпровідник (омічний та випрямний переходи). Гетеропереходи.

Тема 4.3. Напівпровідникові діоди (випрямні та імпульсні). Будова, характеристики, основні параметри. Паралельне та послідовне сполучення діодів. Робота діода в режимах малої та великої інжекції. Діоди з бар'єром Шоткі.

Тема 4.4. Стабілітрони: схема ввімкнення, ВАХ, параметри. Напівпровідникові світловипромінювальні (світло діоди) та світлочутливі прилади (фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори і фототиристри) та області їх використання. Оптрони.

Тема 4.5. НП діоди зі змінною ємністю (варикапи, варактори). НВЧ діоди (параметричні, змішувальні, детекторні, тунельні діоди). Призначення, будова, параметри, застосування.

Тема 5. Біполярні транзистори (БТ).

Тема 5.1. Структура та принцип дії біполярного транзистора. Схеми ввімкнення, режими роботи. Потенціальна діаграма і фізичні процеси в активному режимі. Розподіл неосновних носіїв.

Тема 5.2. Струми в транзисторі. Коефіцієнти передачі струму емітера, бази. Статичні ВАХ транзистора в схемах з спільною базою та спільним емітером. ідеалізованого транзистора. Температурний дрейф характеристик транзистора.

Тема 5.3. Системи малосигнальних параметрів. Визначення параметрів на ВАХ. Зв'язок між системами параметрів і фізичними параметрами. Низькочастотні схеми заміщення транзистора (схема з двома джерелами, П- та Т-подібні схеми). Підсилювальні властивості транзистора для трьох схем ввімкнення. Розрахунок підсилення за ВАХ.

Тема 5.4. Вплив часу прольоту носіїв крізь базу, ємностей емітерного та колекторного переходів, опору бази при роботі на високій частоті. Рубіжна та гранична частоти. Особливості НВЧ транзисторів (дрейфові та гетероперехідні біполярні транзистори).

Тема 5.5. Схема транзисторного ключа. Особливості роботи транзисторного ключа (нагромадження та розосередження об'ємного заряду в базі та колекторі). Параметри транзистора в режимах насичення, відсічки. Власні шуми в транзисторах, джерела шумів.

Тема 6. Тиристори.

Тема 6.1. Чотиришарові перемикальні прилади (диністори, тиристори). Класифікація, будова, принцип дії, ВАХ, застосування.

Тема 7. Польові транзистори.

Тема 7.1. Класифікація. Структура та процеси в МДН-структурі з індукованим каналом. Режими збагачення, збіднення, інверсії. Статичні ВАХ транзистора. Температурний дрейф характеристик. Фізичні параметри: порогова напруга, крутість та ін. Структура, принцип дії. ВАХ МДН-транзистора з вбудованим каналом. Транзистор з довгим каналом. Робота МДН-транзистора в схемах підсилювача та ключа. Імпульсні параметри. Частотні властивості транзистора.

Тема 7.2. Структура, принцип дії, ВАХ та параметри польового транзистора з керувальним р-п переходом. Области застосування. Транзистори для НВЧ з високою рухливістю електронів.

Тема 8. Конструкторсько-технологічні основи мікроелектроніки.

Тема 8.1. Інтегральні схеми (ІС). Класифікація ІС за конструкторсько-технологічними ознаками та функціональному призначенню. Гібридні інтегральні схеми. Монолітні (напівпровідникові) ІС, ВІС, мікросбірки.

Тема 8.2. Технологічні операції виготовлення ІС: епітаксія, дифузія домішок, іонне легування, термічне окислення, травлення, нанесення тонких плівок, створення з'єднань та контактів, фотолітографія, субмікронна та нанолітографія.

Тема 9. Гібридні інтегральні мікросхеми (ГІС).

Тема 9.1. Різновиди ГІС. Елементи ГІС: плівкові резистори, конденсатори, індуктивності, провідники і контактні площадки. Навісні компоненти ГІС.

Тема 10. Напівпровідникові (монолітні) інтегральні мікросхеми.

Тема 10.1. Напівпровідникові біполярні ІС. Епітаксійно-планарний n-p-n транзистор з комбінованою і повною діелектричною ізоляцією; р-р-р транзистори; багатоемітерні та багатоколекторні транзистори, транзистори з діодом Шоткі. Діодні ввімкнення транзисторів. Пасивні елементи напівпровідникових ІС (напівпровідникові та плівкові резистори, конденсатори).

Тема 10.2. МДН-транзистори ІС. Транзистори з кремнійовими самосуміщеними заслонами. Особливості параметрів та характеристик МДН-транзисторів з коротким каналом для НВІС. Елементи НВЧ ІС. Підшарки НВЧ ІС, мікросмужкові лінії передачі, пасивні елементи

Тема 11. Основи цифрової та аналогової мікросхемотехніки.

Тема 11.1. Основи цифрової схемотехніки. Загальні характеристики та параметри логічних елементів цифрових інтегральних мікросхем. Логічні елементи ІС.

Тема 11.2. Основи схемотехніки аналогових ІС. Диференційні каскади. Поняття про операційний підсилювач, його характеристики, параметри та області застосування.

Тема 11.3. Прилади із зарядовим зв'язком. Принцип дії. Використання в аналогових ІС.

Тема 12. Введення в функціональну електроніку та наноелектроніку.

Тема 12.1. Елементи акустoeлектроніки. Лінії затримки, фільтри та резонатори на об'ємних та поверхневих акустичних хвилях, підсилювачі на ПАХ, генератори сигналів на ПАХ, конвольвери та корелятори. Елементи кріoeлектроніки, магнітоелектроніки, хемотроніки, діелектричної, молекулярної, біологічної електроніки.

Тема 12.2. Принципи наноелектроніки. Фізичні основи наноелектроніки. Нанотехнологія. Наноелектронні прилади (Діодні і транзисторні структури).

Зміст розділу 2 «Аналогова схемотехніка»

Тема 1. Вступ. Задачі аналогової схемотехніки. Місце схемотехніки в підготовці сучасного спеціаліста. Мета та задачі дисципліни. Результати навчання.

Тема 2. Принципи підсилення електронними приладами. Еквівалентні схеми за змінним та постійним струмами. Класи роботи підсилювальних каскадів. Елементна база аналогової схемотехніки. Історичний огляд. Етапи проектування пристроїв аналогової електроніки. Пакети симуляції роботи.

Тема 3. Основні характеристики аналогових пристроїв. АЧХ, ФЧХ. Логарифмічні характеристики. АЧХ та ЛАЧХ пасивних кіл.

Тема 4. Зворотний зв'язок. Класифікація. Основні означення (корисний та паразитний ЗЗ, петля ЗЗ, одно- та багатопетлевий ЗЗ, петлеве підсилення, глибина ЗЗ, частотно-залежний та частотно-незалежний ЗЗ). Структурні схеми підсилювачів з різними способами введення та знімання ЗЗ. Вплив ЗЗ на параметри підсилювачів (коефіцієнт підсилення, нестабільність підсилення, вхідний та вихідний опір, лінійні та нелінійні спотворення, рівень власних шумів). Приклади схемотехнічної реалізації ЗЗ в підсилювачах.

Тема 5. Ідеалізовані операційні підсилювачі. Принцип розрахунку схем на операційних підсилювачах. Основні функційні вузли на ОП.

Тема 6. Схеми зміщення біполярних транзисторів. Схеми з фіксованою напругою та фіксованим струмом. Схеми зміщення польових транзисторів з ізольованим заслоном. Схеми зміщення польових транзисторів з вбудованим переходом.

Тема 7. Джерела сталого струму на біполярних та польових транзисторах. Струмові дзеркала. Джерела опорної напруги.

Тема 8. Схеми ввімкнення активних елементів. Аналіз схем. Схеми живлення.

Тема 9. Аналіз АЧХ в області НЧ, СЧ та ВЧ. Корекція амплітудно-частотної характеристики. Розрахунок частотних спотворень. Розрахунок нелінійних спотворень.

Тема 10. Коефіцієнт шуму, еквівалентна вхідна потужність шумів підсилювального каскаду. Шумова смуга підсилювача. Шумові моделі БТ та ПТ. Розрахунок шумових характеристик транзисторних каскадів. Забезпечення малoshумного режиму роботи АЕ. Схемотехніка малoshумних каскадів підсилювачів. Коефіцієнт шуму багатокаскадних підсилювачів. Шуми диференційного каскаду.

Тема 11. Складені каскади на БТ та ПТ. Активне навантаження. Диференціальний підсилювач. Схемотехніка та аналіз.

Тема 12. Багатокаскадні підсилювачі. Міжкаскадний зв'язок.

Тема 13. Двотактні підсилювачі.

Тема 14. Резонансні підсилювачі. Стійкість резонансних підсилювачів. Коефіцієнт стійкості, коефіцієнт стійкого підсилення, методи розрахунку. Методи підвищення стійкості. Схеми з нейтралізацією.

Тема 15. Регулювання в пристроях аналогового оброблення сигналів. Регулювання підсилення. Режимне регулювання. Регулювання міжкаскадними атенуаторами. Регулювання смуги пропускання. Види, схемотехнічна реалізація. Регулювання форми АЧХ.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Рекомендована література для розділу 1

Базова

1. Елементна база радіоелектронної апаратури: Пасивні радіокомпоненти В 4 ч. Ч. 1. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.О.Піддубний, І.О.Товкач. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 98 с. URL https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41346/1/EBRA_1.pdf
2. Елементна база радіоелектронної апаратури: В 4 ч. Ч. 2. Напівпровідники та діоди [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.О.Піддубний, І.О.Товкач. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,83 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 117 с. URL https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41347/1/EBRA_2.pdf
3. Елементна база радіоелектронної апаратури: В 4 ч. Ч. 3. Багатоперехідні структури [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.О.Піддубний, І.О.Товкач. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,09 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 134 с. URL https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41348/1/EBRA_3.pdf
4. Елементна база радіоелектронної апаратури: В 4 ч. Ч. 4. Основи мікроелектроніки [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.О.Піддубний, І.О.Товкач. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,22 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 119 с. URL https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41349/1/EBRA_4.pdf
5. Схемотехніка. Частина 1. Електронні компоненти: Фізичні властивості напівпровідників [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.О.Піддубний – Електронні текстові дані (1 файл: 2,0 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 72 с. – Назва з екрана. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54655>
6. Схемотехніка. Частина 1. Електронні компоненти: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.О.Піддубний, І.О.Товкач. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 85 с. – Назва з екрана. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54658>
7. Твердотільна електроніка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 153 «Мікрота наносистемна техніка» / О. В. Борисов, Ю. І. Якименко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 19,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 484 с. URL https://me.kpi.ua/downloads/Borysov_Yakymenko_TTE_2018.pdf

Допоміжна

1. Троцишин І.В. Фізичні основи електронних приладів: Навчальний посібник / І.В.Троцишин – Хмельницький: ХДУ. – 2004. – 488 с.
2. Борисов О.В. Твердотільна електроніка / О.В.Борисов, Ю.І.Якименко – К.: БХВ – НТУУ «КПІ», 2015. – 484 с.
3. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник / За ред. Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди. – К.: Вища шк., 1999. – 838 с
4. Шуаїбов О.К. Низьковольтна імпульсна електроніка / Шуаїбов О.К., Шевера І.В., Малініна А.О., Малінін О.М. – Ужгород, Ужгородський національний університет, 2018, –236 с.
5. Прищепка М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка. Елементи мікросхем. Збірник задач. Навч. посіб. / За ред. М. М, Прищепи. – К.: Вища шк., 2005. – 167 с.
6. Прищепка М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки: Навч. посіб. / За ред. М.М, Прищепи. – К.: Вища шк., 2004. – 431 с.
7. Прищепка М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка: В 3 ч. Ч. 2. Елементи мікросхемотехніки: Навч. посіб. / За ред. М.М. Прищепи. – К.: Вища шк., 2006. – 503 с.
8. Asadi F. Essential Circuit Analysis Using Ni Multisim (tm) and MATLAB®. – Springer Nature, 2022.

Дистанційний курс навчання викладено на платформі дистанційного навчання Moodle МікроТік (<http://iot.kpi.ua/lms/course/view.php?id=28>) та на платформі НТУУ КПІ Сікорський дисципліна «Схемотехніка. Частина 1. Електронні компоненти»

<https://do.ipk.kpi.ua/course/view.php?id=6394>

Подивитися матеріали про диференційний підсилювач, відеолекцію з теоретичного матеріалу та практичне виконання лабораторної роботи (для ознайомлення) можна на

<https://www.youtube.com/watch?v=UPMSP3MSNyU> - лекція

та https://www.youtube.com/watch?v=FmlpvqyG_0k – лабораторна робота.

Рекомендована література для розділу 2

Базова

1. Сєдов, С. О. Аналогове оброблення сигналів. Схемотехніка. Розрахунки [Електронний ресурс] : підручник / С. О. Сєдов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 298 с.
2. Оброблення сигналів на базі операційних підсилювачів. Схемотехніка. Розрахунки: Навч. посіб. / Сергій Олексійович Сєдов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 132 с.: іл.
3. The Art of Electronics by Paul Horowitz, Winfield Hill, 3rd edition, 2015, 1220 pages, ISBN-10: 978052180926
4. Learning the Art of Electronics: A Hands-On Lab Course - Hayes, Thomas C., Horowitz, Paul, 2016, ISBN: 9780521177238
5. The Art of Electronics: The x Chapters - Horowitz, Paul, Hill, Winfield, 2020, ISBN: 9781108499941
6. Joseph D. Greenfield / Practical Transistors and Linear Integrated Circuits Paperback - January 1, 1988. P.233
7. Jones M. H. et al. A practical introduction to electronic circuits. – Cambridge University Press, 1995.
8. Baker B. A Baker's Dozen: Real analog solutions for digital designers. – Elsevier, 2005.

Допоміжна

1. Kaufman M., Seidman A. H. (ed.). Handbook of electronics calculations for engineers and technicians. – McGraw-Hill Companies, 1988.
2. Boylestad R. L., Nashelsky L. Electronic devices and circuit theory. – Prentice Hall, 2012.
3. Fish P. J. Electronic noise and low noise design. – Macmillan International Higher Education, 2017.
4. Palumbo G., Pennisi S. Feedback amplifiers: theory and design. – Springer Science & Business Media, 2002.

5. Schubert Jr T. F., Kim E. M. Fundamentals of Electronics: Book 2: Amplifiers: Analysis and Design. – Morgan & Claypool Publishers, 2015.
6. Прищеп М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки: Навч. посіб. / За ред. М. М. Прищепи. - К.: Вища шк., 2004. - 431 с.: іл.
7. Прищеп М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка: В 3 ч. Ч. 2. Елементи мікросхемотехніки: Навч. посіб. / За ред. М. М. Прищепи. - К.: Вища шк., 2006. - 503 с.: іл.
8. Сухов М. Є. / Схемотехніка високоякісного звуковідтворення [Текст] / М. Є. Сухов, С. Д. Бать, В. В. Колосов, О. Г. Чупаков. - К. : Техніка, 1992. - 127 с.
9. Asadi F. Essential Circuit Analysis Using Ni Multisim (tm) and MATLAB®. – Springer Nature, 2022.
10. Báez-López D., Guerrero-Castro F. E., Cervantes-Villagómez O. D. Advanced circuit simulation using Multisim Workbench //Synthesis Lectures on Digital Circuits and Systems. – 2012. – Т. 7. – №. 1. – С. 1-144.
11. Asadi F. Electric and Electronic Circuit Simulation using TINA-TI®. – CRC Press, 2022.
12. Bruun E. CMOS Integrated Circuit Simulation with LTspice. – 2017.
13. Mohindru P., Mohindru P. Electronic Circuit Analysis Using LTSpice XVII Simulator: A Practical Guide for Beginners. – CRC Press, 2021.
14. Asadi F. Simulation of Electric Circuits with LTspice® //Essential Circuit Analysis using LTspice®. – Springer, Cham, 2023. – С. 1-175.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекції (72 години) проводяться в відповідності до змісту матеріалу навчальної дисципліни в режимі of line в відповідності до розкладу деканату або в режимі online в Zoom.

Перелік питань винесених на лекційні заняття (розділ 1) (36 годин)

№	Назва теми лекції та перелік основних питань
1	Компоненти РЕА. Загальна характеристика компонентної бази РЕА. Загальні відомості про пасивні та активні радіоелементи. Призначення та основні характеристики матеріалів. Класифікація. Діелектричні матеріали. Фізичні процеси в діелектриках. Пасивні та активні діелектрики. Діелектрики, які використовуються в РЕЗ. Неполарні ВЧ полімери. Слабополарні НЧ полімери. Поларні НЧ полімери. Композиційні діелектричні матеріали. Лаки, емалі, компаунди. Діелектричні матеріали для друкованих плат та ГІС. Радіотехнічна кераміка. Сегнето-, п'єзоелектрики, електрики. Газоподібні, рідкі діелектрики. Конденсатори постійної та змінної ємності. Призначення. Класифікація. Основні характеристики. Ряди номінальних значень ємності та ряди допусків. Високочастотні та низькочастотні конденсатори. Схеми заміщення. Конструкції конденсаторів постійної та змінної ємності. Конденсатори спеціального призначення: варистори та варікапи.
2	Провідникові та резистивні матеріали. Основні властивості провідникових матеріалів. Матеріали високої провідності для навісного монтажу, друкованих плат та інтегральних мікросхем. Обмоточні та радіомонтажні дроти. Матеріали високого питомого опору (манганін, константан, ніхром, сплав МЛТ, кермет, вуглець, металосиліциди). Резистори постійного та змінного опору. Основні характеристики та схеми заміщення. Ряди номінальних значень опору і ряди допусків. Типи резисторів (навісні, для друкованого монтажу, надвисокочастотні та інші.). Резистори для гібридних та інтегральних мікросхем.
3	Магнітні матеріали. Характеристика магнітних матеріалів. Магнітом'які та магнітотверді матеріали. Трансформаторне залізо. Феро- та феримагнетики. Ферити та магнітодіелектрики. Магнітні плівки. Котушки індуктивності. Характеристики

	<p>катушок індуктивності. Типи намоток. Високочастотні катушки індуктивності. Їх призначення та конструкції. Схеми заміщення. Варіометри. Друковані катушки індуктивності. Гіратори. Магнітні матеріали спеціального призначення. Катушки індуктивності для ПС. Дроселі та трансформатори. Магнітні осердя. Обмотки трансформаторів та дроселів. Конструкції НЧ та ВЧ дроселів та трансформаторів. Особливості роботи на підвищених частотах. Класифікація контактних та комутаційних пристроїв. Схеми заміщення, основні параметри і характеристики. Перемикачі. Реле. З'єднувачі. Контактні та комутаційні пристрої мікросбірок та мікроблоків. Друковані плати та їх класифікація. Матеріали друкованих плат. Конструкція друкованих плат. Особливості друкованих плат НВЧ діапазону (матеріали та плати). Плати персональних ПК та іншої сучасної електронної техніки. Smd – компоненти та технологія.</p>
4	<p>Основні матеріали НП приладів. Типи кристалічних решіток. Основи зонної теорії. носії зарядів у власних та домішкових НП. Основні та неосновні носії зарядів. Генерація та рекомбінація вільних носіїв заряду. Види генерацій та рекомбінації. Рівноважний та нерівноважений стани НП. Концентрація носіїв заряду у власному та домішковому НП. Рівень Фермі для власного та домішкового НП. Залежність рівня Фермі від температури та концентрації домішок. Рівень Фермі – електротехнічний потенціал.</p>
5	<p>Дрейфовий струм носіїв заряду, рухливість носіїв, залежність рухливості від температури, концентрації домішок, напруженості електричного поля. Густина дрейфового струму. Електропровідність НП. Дифузійний струм. Дифузійний рух часток, коефіцієнт дифузії, дифузійна довжина. Рівняння дифузії та його зв'язок. Рівняння повного струму. Властивості поверхні НП: поверхневі стани, їх густина, поверхневий заряд та поверхнева рекомбінація. Ефект поля.</p>
6	<p>Різновиди електричних переходів. Контактна різниця потенціалів. Контакт метал-напівпровідник: омичні та випрямні переходи. ВАХ переходу, параметри. Гетероперехід. Електронно-дірковий перехід (p-n перехід). Перехід в рівноважному стані: потенціальний бар'єр, потенціальна діаграма, ширина переходу. Перехід в нерівноважному стані: інжекція, екстракція, потенціальний бар'єр, потенціальна діаграма, ширина переходу. ВАХ ідеалізованого переходу: тепловий струм, диференційний опір. ВАХ реального переходу: струми генерації, рекомбінації, опір бази, пробої переходу, ємності переходу.</p>
7	<p>Класифікація НП діодів. Випрямні діоди. Будова, характеристики, основні параметри. Послідовне та паралельне сполучення діодів. Імпульсні діоди. Робота діода в режимах перемикачів з малими та великими рівнями інжекції. Типи випрямних та імпульсних діодів. Кремнієві стабілітрони. ВАХ, параметри. Варикапи, варактори, параметричні діоди: призначення, будова характеристики, параметри, моделі. Напівпровідникові випромінювальні прилади. Детекторні і змішувальні діоди. Тунельні діоди, обернені діоди. Будова, принцип дії, характеристики, параметри, моделі. Застосування діодів.</p>
8	<p>Біполярні транзистори (БТ). Типи БТ, схеми ввімкнення, режими роботи. Структура планарно-епітаксійного БТ. Потенціальна діаграма та фізичні процеси в активному режимі. Струми транзистора. Розподіл неосновних носіїв в транзисторі. Принцип підсилення БТ.</p>
9	<p>Коефіцієнти передачі струму. Фізичні параметри. Статичні ВАХ БТ. Модель Еберса-Молла. ВАХ в схемах із спільною базою та спільним емітером. Температурний дрейф характеристик. Системи малосигнальних параметрів. Визначення параметрів за ВАХ. Зв'язок між системами параметрів і фізичними параметрами. Схеми з двома джерелами, П- та Т-подібні схеми. Робота транзистора в схемі підсилення напруги на низькій частоті, графоаналітичний розрахунок режиму підсилення. Підсилювальні властивості БТ для трьох схем ввімкнення.</p>

10	Частотні властивості БТ. Вплив часу прольоту носіїв, опору бази, ємностей переходів на роботу транзистора. Моделювання БТ на високій частоті. Рубіжна, гранична частоти. Особливості НВЧ транзисторів. Дрейфові, гетероперехідні транзистори. Схеми заміщення транзистора на високій частоті. Схема транзисторного ключа. Нагромадження та розосередження об'ємного заряду в базі та колекторі. Перехід від режиму відсічки в активний режим і режим насичення. Параметри БТ в режимах відсічки та насичення. Імпульсні параметри.
11	Власні шуми в транзисторах, джерела шумів. Шумові параметри. Залежність шумових параметрів від режимів узгодження і роботи. Низькочастотні малопотужні транзистори, високочастотні малопотужні транзистори, НВЧ транзистори, потужні транзистори. Чотиришарові перемикальні прилади. Динистори, тиристори. Класифікація. Будова, принцип дії, основні параметри, ВАХ, застосування.
12	Типи польових транзисторів (ПТ). Структура та принцип дії МДН-транзистора з індукованим каналом. Фізичні процеси в МДН-структурі. Режими збіднення, збагачення, інверсії. Схеми ввімкнення ПТ. Сімейство ВАХ ПТ. Температурний дрейф характеристик. Параметри МДН-транзистора. Структура, принцип дії ВАХ МДН-транзистора з вбудованим каналом. МДН-транзистор як лінійний чотириполюсник. Система малосигнальних параметрів. Робота МДН-транзистора на ВЧ. Малосигнальна схема ПТ на ВЧ. Вплив ємностей на роботу ПТ. Рубіжна та гранична частоти транзистора.
13	Будова і принцип дії транзистора з керівним р-п переходом. ВАХ і параметри. Транзистори з гетеропереходом. ПТ. Будова і принцип дії транзистора. Статичні ВАХ транзистора, диференційні параметри транзистора. Температурний дрейф ВАХ. Три схеми ввімкнення транзистора. Інтегральні мікросхеми (ІС). Класифікація ІС за конструкторсько-технологічними ознаками та функціональним призначенням. Гібридні інтегральні схеми, напівпровідникові ІС, ВІС, мікрозбірки.
14	Основні етапи створення ІС. Технологічні операції: епітаксія, дифузія домішок, іонне легування, термічне окислення, травлення. Нанесення тонких плівок, створення з'єднань та контактів. Фотолітографія та субмікронна літографія. Нанотехнологія. Матеріали підшарків ГІС. Елементи ГІС: плівкові резистори, конденсатори, індуктивності, провідники і контактні площадки. Вплив матеріалів і конструкції ГІС на точнісні характеристики та розкид параметрів. Основи розрахунку пасивних елементів. Навісні компоненти ГІС.
15	ІС на БТ. Напівпровідникові біполярні ІС. Епітаксійно-планарний п-р-п транзистор з комбінованою і повною діелектричною ізоляцією. Багатоємні та багатоколекторні транзистори, транзистори з діодом Шоткі. Діодні ввімкнення транзисторів. Напівпровідникові та плівкові резистори, конденсатори, структури і параметри. Технологія виготовлення біполярних ІС. Основні властивості біполярних ІС. МДН-транзистори в напівпровідникових ІС. Транзистори з кремнійовими самосуміщеними заслонами. Особливості параметрів та характеристик транзисторів з коротким каналом для НВІС.
16	Поняття про мікросхемотехніку і її загальні принципи, обумовлені інтегральною технологією. Відмінність мікросхемотехніки від схемотехніки на дискретних компонентах. Основи цифрової схемотехніки. Транзисторні ключі на БТ. Навантажувальна здатність ключа. Логіки ТТЛ, ЕЗЛ, І-І-Л. Їх основні параметри. порівняльні характеристики логік. Перемикач струму. МДН-транзисторні ключі. Ключ з динамічним навантаженням. Комплементарний ключ. Завадостійкість ключів. Логічні елементи ВІС на п-канальних та комплементарних МДН-транзисторах, їх структури, принцип дії, параметри. Програмовані логічні ІС.
17	Основи схемотехніки аналогових ІС. Поняття про диференційний і операційний підсилювачі, їх характеристики, параметри та області застосування. Генератори струму та напруги, вихідні каскади ІС. Введення в функціональну електроніку та

	наноелектроніку. Елементи акустоелектроніки. Лінії затримки, фільтри та резонатори на об'ємних та поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), підсилювачі на ПАХ, генератори сигналів на ПАХ, конвольвери та корелятори.
18	Елементи кріоелектроніки, магнітоелектроніки, хемотроніки, діелектричної, молекулярної, біоелектроніки. Принципи наноелектроніки. Фізичні основи наноелектроніки. Нанотехнологія. Наноелектронні прилади (Діодні і транзисторні структури).

Перелік питань винесених на лекційні заняття (розділ 2) (36 годин)

№	Назва теми лекції та перелік основних питань
1	Вступ. Задачі аналогової схемотехніки. Місце схемотехніки в підготовці сучасного спеціаліста. Мета та задачі дисципліни. Результати навчання.
2	Принципи підсилення електронними приладами. Еквівалентні схеми за змінним та постійним струмами. Класи роботи підсилювальних каскадів. Елементна база аналогової схемотехніки. Історичний огляд. Етапи проектування пристроїв аналогової електроніки. Пакети симуляції роботи.
3	Основні характеристики аналогових пристроїв. АЧХ, ФЧХ. Логарифмічні характеристики. АЧХ та ЛАЧХ пасивних кіл.
4	Зворотний зв'язок. Вплив зворотного зв'язку на параметри.
5	Ідеалізовані операційні підсилювачі. Принцип розрахунку схем на операційних підсилювачах.
6	Схеми зміщення біполярних транзисторів. Схеми з фіксованою напругою та фіксованим струмом. Схеми зміщення польових транзисторів з ізольованим заслоном. Схеми зміщення польових транзисторів з вбудованим переходом.
7	Джерела сталого струму на біполярних та польових транзисторах. Струмові дзеркала. Джерела опорної напруги.
8	Схеми ввімкнення активних елементів. Аналіз схем. Схеми живлення.
9	Аналіз АЧХ в області НЧ, СЧ та ВЧ. Корекція амплітудно-частотної характеристики. Розрахунок частотних спотворень. Розрахунок нелінійних спотворень.
10	Розрахунок шумових характеристик транзисторних каскадів. Шумові моделі.
11	Складені каскади на БТ та ПТ. Активне навантаження. Диференціальний підсилювач. Схемотехніка та аналіз.
12	Багатокаскадні підсилювачі. Міжкаскадний зв'язок.
13	Двотактні підсилювачі. Принципи побудови та схемотехніка.
14	Двотактні підсилювачі. Підсилювачі потужності.
15	Резонансні підсилювачі.
16	Стійкість резонансних підсилювачів.
17	Регулювання в пристроях аналогового оброблення сигналів.
18	Аналогові пристрої на сучасних ІС. Наскрізне проектування аналогових підсилювальних пристроїв. Машинне моделювання

Лабораторні заняття (розділ 1) (18 годин)

Проводяться для:

- поглиблення і закріплення теоретичних знань;
- набуття навиків експериментальних досліджень;
- набуття навиків роботи з вимірювальною апаратурою;
- набуття навиків роботи в комп'ютерному стимуляторі схем Multisim (Trial);
- набуття навиків оцінки достовірності отриманих результатів;
- набуття навиків оформлення документів.

Виконуються наступні лабораторні роботи:

1. Дослідження кремнієвого стабілітрона – 6 годин.
2. Дослідження вольт-амперних характеристик транзистора та розрахунок h -параметрів – 6 годин.
3. Робота транзистора в ключовому режимі – 6 годин.

Студенти в кінці семестру для підвищення рейтингу можуть виконати (за бажанням) додаткову лабораторну роботу (індивідуальне заняття): "Дослідження інтегральної мікросхеми диференційного підсилювача".

В режимі дистанційного навчання лабораторні виконуються на домашньому персональному комп'ютері в відповідності до вимог, що наведені в дистанційному курсі <http://iot.kpi.ua/lms/course/view.php?id=28> . Додаткова робота проводиться в ознайомчому режимі за відповідними матеріалами (текстові документи з фото та відео на Ютуб, пояснення в Zoom).

Лабораторні роботи починаються з вступного заняття в Zoom а потім проводяться студентами самостійно. При роботі в лабораторії заняття проводяться на лабораторних макетах в ауд. 208-17.

Лабораторні заняття (розділ 2) (18 годин)

Метою лабораторних занять є експериментальна перевірка теоретичних знань, набуття навиків розрахунку, дослідження, вимірювання та оцінки конкретних параметрів підсилювальних пристроїв та їх каскадів.

Лабораторні заняття проводяться у вигляді лабораторного практикуму на макетах в лабораторії. Для дистанційного навчання дані лабораторні роботи адаптовані для проведення в програмі симуляторі NI Multisim.

Завдання на лабораторні роботи студенти отримують заздалегідь. Перед початком заняття проводиться опитування для того, щоб оцінити готовність студента до проведення роботи. Після виконання роботи відбувається захист та обговорення отриманих результатів. Оформляється звіт по лабораторній роботі.

Виконуються наступні лабораторні роботи:

1. Лабораторна робота №1: Вимірювання параметрів підсилювача звукових частот;
2. Лабораторна робота № 2: Дослідження параметрів підсилювача з негативним зворотним зв'язком;
3. Лабораторна робота № 3: Дослідження схем зміщення транзисторних каскадів;
4. Лабораторна робота № 4: Дослідження транзисторних підсилювальних каскадів в області середніх частот.

Практичні заняття (розділ 2) (36 годин)

Теми комп'ютерного практикуму:

1. Схеми зміщення транзисторних каскадів;
2. Схеми ввімкнення біполярних транзисторів;
3. Аналіз АЧХ транзисторного підсилювача;
4. Дослідження підсилювача на інтегральній схемі.

В режимі дистанційного навчання лабораторні виконуються на домашньому персональному комп'ютері. Додаткова робота проводиться в ознайомчому режимі за відповідними матеріалами (текстові документи з фото та відео на Ютуб, пояснення в Zoom).

Лабораторні роботи починаються з вступного заняття в Zoom а потім проводяться студентами самостійно. При роботі в лабораторії заняття проводяться на лабораторних макетах в ауд. 512-17.

При вивченні дисципліни заплановано **індивідуальні завдання** (домашня контрольна робота з розділу 1). Метою цього індивідуального завдання є:

- опанування навчальної програми в повному об'ємі;
- набуття навичок роботи з літературою, оформлення технічної документації в відповідності до ДСТУ 3008-2015, оформлення коротких тез для публікації на науково-технічних конференціях, проведення розрахунків і оцінки їх результатів;
- поглиблення та розширення матеріалів викладених в лекціях.

Індивідуальні завдання виконуються за темами індивідуально заданим студентам.

Студент має право за узгодженням з викладачем вибрати іншу тему, яка стосується матеріалів дисципліни, або уточнити перелік питань вибраної зі списку.

Терміни здачі робіт вказані в Moodle.

6. Самостійна робота студента

На самостійну роботу студентів відводиться 66 годин. Вона складається з підготовки до розділу 1 (26 годин):

- Опрацювання матеріалу лекцій за лекційними матеріалами – 9 год.;
- підготовки до лабораторних робіт, проведення необхідних розрахунків та оформлення протоколів лабораторних робіт, підготовка до захисту лабораторних робіт – 6 год.;
- виконання домашньої контрольної роботи – 9 год.;
- підготовка до модульних контрольних робіт – 2 год.

3 підготовки до розділу 2 (40 годин):

- Опрацювання матеріалу лекцій за лекційними матеріалами – 9 год.;
- підготовки до лабораторних робіт, проведення необхідних розрахунків та оформлення протоколів лабораторних робіт, підготовка до захисту лабораторних робіт – 6 год.;
- виконання домашньої контрольної роботи – 3 год.;
- підготовка до модульних контрольних робіт – 2 год.
- підготовка до екзамену – 20 годин.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:

- **правила відвідування занять** – всі заняття проводяться в аудиторії або в дистанційному режимі, лекції та лабораторні роботи проводяться в відповідності до розкладу наданого деканатом. Контроль здійснюється на занятті викладачем, якщо воно проводиться в аудиторії, або за результатами тестів та надходженню звітів про виконання лабораторних робіт, якщо воно дистанційне. Відвідування занять обов'язкове.
- **правила поведінки на заняттях** – необхідно виконувати загально установлені правила поведінки на заняттях. При проведенні контрольних заходів не допускається списування та використання ноутбуків та телефонів. Під час проведення лабораторних робіт допускається та бажано використання вказаних засобів;
- **правила захисту** лабораторних робіт та індивідуальних завдань вказано в розділі рейтингова система оцінювання результатів навчання. Заохочувальні бали призначаються за активну участь в роботі семінарів кафедри а штрафні за несвоєчасну здачу контрольних завдань (тестів) та звітів лабораторних робіт;
- **терміни здачі матеріалів** встановлюються індивідуально та доводяться до студентів в Moodle та надсилаються на групову пошту студентів чи в групу Телеграм. Студенти, які набрали за семестр рейтинг менше 60 балів, до початку сесії в терміни узгоджені з викладачем можуть підвищити рейтинг і бути допущеними до екзамену.

Політика академічної доброчесності лежить на совісті студентів та контролюється викладачем шляхом порівнянь змісту індивідуальних завдань.

Студенти мають можливість отримати знання з окремих тем та розділів навчальної дисципліни на навчальних курсах платформи дистанційного навчання Сікорський (<https://do.ipk.kpi.ua/course/view.php?id=6394> , <https://do.ipk.kpi.ua/course/view.php?id=6417>) та платформі МікроТік (<http://iot.kpi.ua/lms/course/view.php?id=28>), у якості змішаного чи додаткового навчання згідно Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (<https://osvita.kpi.ua/node/179>).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Розподіл балів по частинам: розділ 1 – 30 балів, розділ 2 – 30 балів, екзамен - 40 балів.

Розділ 1

Поточний контроль: виконання лабораторних робіт (звіти – 5x3 балів), тест по ЛР (захист – 10x3 балів), дві МКР (20x2балів), домашня контрольна робота (5x1 балів)

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: відсутній

Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне завдання та зарахування усіх лабораторних робіт. Семестровий рейтинг повинен бути більше 15 балів.

Рейтингова оцінка з розділу 1 дисципліни RD формується як сума балів поточної успішності навчання.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за:

1. Виконання та захист 3 лабораторних робіт.
2. Виконання індивідуального завдання.
3. Модульний контроль. Виконується дві МКР тривалістю по 30 хвилин (в Moodle).

Пункти 1-3 складають суму балів поточної успішності навчання і є основним в рейтингу дисципліни. Оцінка може бути покращена шляхом виконання додаткового індивідуального завдання.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання:

1. Лабораторні роботи.

За кожне заняття по ЛР нараховуються бали:

- оформлення звіту відповідно до вимог – 5 бали;
- захист лабораторної роботи (тест в системі Moodle, вхід за посиланням iot.kpi.ua/lms, дисципліна «Схемотехніка. Частина 1. Електронні компоненти») – 10 бали;

Максимальна сума балів за ЛР – 45 балів.

2. Модульний контроль МКР має 2 питання. За кожне питання нараховуються бали:

- повна відповідь – 10 балів;
- достатньо повна відповідь (має неістотні неточності) – 8 бали;
- відповідь не повністю розкриває питання, є деякі помилки – 8 бали;
- немає відповіді, неправильна відповідь - 0 балів.

Максимальна сума балів за один МКР – 20 балів.

Сумарна кількість балів за два МКР – 40 балів.

3. Індивідуальна (домашня контрольна робота) робота виконується в вигляді реферату.

Вона оцінюється наступним чином:

- повне розкриття теми, наявність ґрунтовних висновків, посилання на сучасні джерела інформації 5 балів – «відмінно»;
- достатньо повна відповідь (розкрита не менше 80% потрібної інформації, або є незначні неточності) 4 бали – «дуже добре»;

- тема в цілому розкрита, зроблені висновки, відображена власна позиція – 3 бали – «добре»;
- тема розкрита неповністю, реферат компілятивного рівня, посилання на застарілі джерела – 2 бали – «задовільно»;
- тема не розкрита, відсутні висновки, посилання на застарілі джерела інформації – «незадовільно». Завдання не зараховано.
Максимальна сума балів – 5 балів

Сума максимально можливих балів контрольних заходів (п.1-3) протягом семестру складає:
 $RD = (15+10+5)/3 = 30$ балів.

Семестрова оцінка виставляється автоматично, як сума оцінок за всі завдання, і передається викладачу розділу 2.

Розділ 2

Поточний контроль: виконання лабораторних робіт та їх захист (5x4 балів), дев'ять МКР (9x3 балів), РГР (13x1 балів)

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: відсутній

Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне завдання та зарахування усіх лабораторних робіт. Сумарний семестровий рейтинг повинен бути більше 30 балів.

Рейтингова оцінка з дисципліни RD формується як сума балів поточної успішності навчання та розраховується за 60 бальною шкалою.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за:

4. Виконання та захист 4 лабораторних робіт.
5. Виконання індивідуального завдання (РГР).
6. Модульний контроль. Виконується дев'ять МКР тривалістю по 10 хвилин.

Пункти 4-6 складають суму балів поточної успішності навчання і є основним в рейтингу дисципліни. Оцінка може бути покращена шляхом виконання додаткового індивідуального завдання.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання:

4. Лабораторні роботи.

За кожне заняття по ЛР нараховуються бали:

- оформлення звіту відповідно до вимог та своєчасний захист результатів (протягом тижня після виконання роботи) – 5 балів; оформлення звіту відповідно до вимог та здача з запізненням (більше ніж через тиждень після виконання роботи) – 4 бали; оформлення звіту відповідно до вимог і неповні відповіді на захисті - 3 бали; оформлення звіту відповідно до вимог і невідповідні відповіді на захисті - 2 бали; оформлення звіту відповідно до вимог - 1 бал.

Максимальна сума балів за ЛР – 20 балів.

5. Модульний контроль МКР має 3 питання. За кожне питання нараховуються бали:

- повна відповідь – 1 бал;
- немає відповіді, неправильна відповідь - 0 балів.

Максимальна сума балів за один МКР – 3 бали.

Сумарна кількість балів за дев'ять МКР – 27 балів.

6. Індивідуальна (РГР) робота виконується в вигляді розрахункової роботи у вигляді розв'язку 13 задач підвищеної складності.

Вона оцінюється наступним чином:

- Повне рішення задачі – 1 бал;

- Неправильний розв'язок або відсутність розв'язку – 0 балів .

Максимальна сума балів – 13 балів

Сума максимально можливих балів контрольних заходів (п.4-6) протягом семестру складає:
 $RD = (20+27+13)/2 = 30$ балів.

З результатом роботи над розділом 1 та 2 студент отримує сумарний рейтинг. Для допуску до екзамену сумарний рейтинг повинен бути не менше 40 балів.

Екзамен

Екзамен складається в письмовій формі вигляді письмової відповіді на білети (5 практичних та теоретичних питань) (5x8 балів). Кожне питання оцінюється у 8 балів.

- повна відповідь – 8 балів;
- достатньо повна відповідь (має неістотні неточності) – 6 бали;
- відповідь не повністю розкриває питання, є деякі помилки – 4 бали;
- немає відповіді, неправильна відповідь - 0 балів.

Приклади питань екзаменаційного білета:

1. Класифікація підсилювачів. Узагальнена структура підсилювача та енергетичні співвідношення. Схема принципова найпростішого підсилювача. Принцип роботи підсилювача.
2. Лінійні спотворення (амплітудні, фазові), причини виникнення, їх зв'язок з АЧХ та ФЧХ. Способи зменшення лінійних спотворень.
3. Зворотний зв'язок у підсилювальних пристроях. Види, класифікація. Узагальнена структурна схема підсилювача із ЗЗ.
4. Вплив послідовного ЗЗ на вхідний опір підсилювальних пристроїв (вивід ф-ли).
5. Температурна нестабільність режиму роботи. Причини виникнення. Способи зменшення.
6. Схеми зміщення з фіксованою напругою бази. Характеристика, приклади схемної реалізації.
7. Принципова схема резисторного каскаду. Еквівалентна схема та аналіз АЧХ резисторного каскаду в області НЧ. Вплив параметрів елементів на коефіцієнт частотних спотворень Мнч (вивід формули).
8. Складені транзистори. Пари Дарлінгтона, використання в підсилювальних пристроях.
9. Основні схеми ввімкнення АЕ: зі СЕ, СБ, СК. Принципові та еквівалентні схеми. Особливості використання.
10. Селективні підсилювачі, основні параметри (K_0 , смуга пропускання, селективність, нерівномірність на краях спектра, коефіцієнт прямокутності АЧХ).

Результуюча оцінка складається з семестрової складової розділу 1 (максимум 30 балів), розділу 2 (максимум 30 балів) та екзаменаційної складової (максимум 40 балів).

Результуючі оцінки з дисципліни вносяться до залікової відомості та книжки.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Дистанційний курс навчання викладено на платформі дистанційного навчання Moodle МікроТік <http://iot.kpi.ua/lms/course/view.php?id=28> та на платформі НТУУ КПІ Сікорський дисципліна «Схемотехніка. Частина 1. Електронні компоненти» <https://do.ipk.kpi.ua/course/view.php?id=6394> «Схемотехніка. Частина 2. Аналогова схемотехніка» <https://do.ipk.kpi.ua/course/view.php?id=6417>

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення розділу 1 дисципліни

Для ефективного засвоєння матеріалу проводяться наступні лабораторні роботи:

Назва лабораторної роботи:

- Дослідження кремнієвого стабілітрона (2 макета)
- Дослідження імпульсних властивостей напівпровідникового діода (2 макета)
- Дослідження вольт-амперних характеристик транзистора (2 макета) - Робота транзистора в ключовому режимі (2 макета)
- Дослідження базового елемента транзисторно-транзисторної логіки (2 макета)
- Дослідження інтегральної мікросхеми диференційного підсилювача (1 макет)

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення розділу 2 дисципліни

Для ефективного засвоєння матеріалу проводяться наступні лабораторні роботи:

Назва лабораторної роботи:

- Вимірювання параметрів підсилювача (8 макетів)
- Зворотний зв'язок в різних варіантах. (8 макетів)
- Дослідження схем зміщення (8 макетів)
- Дослідження схем ввімкнення (8 макетів)

Вони забезпечують поглиблення і закріплення теоретичних знань; набуття навиків експериментальних досліджень; набуття навиків роботи з вимірювальною апаратурою; оцінка достовірності отриманих результатів; набуття навиків оформлення документів

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено Піддубний В.О., Мовчанюк А.В.

Ухвалено кафедрою радіотехнічних систем (протокол № 06/2025 від 21 червня 2025 р.)

кафедрою прикладної радіоелектроніки ([протокол № 06/2025 від 25 червня 2025 р.](#))

Погоджено Методичною комісією факультету/ННІ¹ (протокол № 06/2025 від 26 червня 2025 р.)

¹ Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.